(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 8. Januar 2004 (08.01.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/004108 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: H02M 5/458, 5/45
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/002016
- (22) Internationales Anmeldedatum:

16. Juni 2003 (16.06.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

DE

- (30) Angaben zur Priorität: 102 28 825.9 27. Juni 2002 (27.06.2002)
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FUCHS, Andreas [DE/DE]; Wolfsstaudenring 11, 91056 Erlangen (DE).

- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

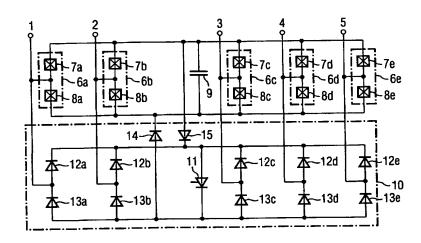
- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten JP, europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR)
- Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: CIRCUIT ARRANGEMENT WITH A VOLTAGE LINK CONVERTER
- (54) Bezeichnung: SCHALTUNGSANORDNUNG MIT EINEM SPANNUNGSZWISCHENKREISUMRICHTER



(57) Abstract: The invention relates to a circuit arrangement with a voltage link converter, comprising a link capacitor (9) and circuit branches (6a to 6e) arranged parallel thereto. Said circuit branches (6a to 6e) each comprise circuit elements (7a to 7e and 8a to 8e), connected in series. A short circuit thyristor (11) is provided to protect against short circuit currents. A short circuit protection arrangement (10) is provided for connection to the link circuit capacitor (9) and the circuit branches (6a to 6e). The above comprises a parallel connection of the short circuit thyristors (11) with opposed conducting pairs of protective diodes (12a to 12e and 13a to 13e) connected in series. The short circuit protection arrangement (10) is connected parallel to the link circuit capacitor (9) and each connection point between two circuit elements (7a to 7e and 8a to 8e) of a circuit branch (6a to 6e) which are connected in series, is connected to a connection point between two protection diodes (12a to 12e and 13a to 13e) of the short circuit protection arrangement (10) which are connected in series.

WO 2004/004108 A1



 vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung mit einem Spannungszwischenkreisumrichter, der einen Zwischenkreiskondensator (9) und parallel zu diesem angeordnete Schaltzweige (6a bis 6e) enthält. Diese Schaltzweige (6a bis 6e) weisen jeweils zwei in Serie geschaltete Schaltelemente (7a bis 7e und 8a bis 8e) auf. Zum Schutz vor Kurzschlussströmen ist ein Kurzschlussthyristor (11) vorhanden. Es ist vorgesehen, dass mit dem Zwischenkreiskondensator (9) und mit den Schaltzweigen (6a bis 6e) eine Kurzschlussschutzanordnung (10) verbunden ist. Diese besteht aus einer Parallelschaltung des Kurzschlussthyristors (11) mit entgegengesetzt zu diesem durchlässigen Paaren von in Serie geschalteten Schutzdioden (12a bis 12e und 13a bis 13e). Die Kurzschlussschutzanordnung (10) ist parallel zum Zwischenkreiskondensator (9) geschaltet und jeweils ein Anschlusspunkt zwischen zwei in Serie geschalteten Schaltelementen (7a bis 7e und 8a bis 8e) eines Schaltzweiges (6a bis 6e) ist mit jeweils einem Anschlusspunkt zwischen zwei in Serie geschalteten Schutzdioden (12a bis 12e und 13a bis 13e) der Kurzschlussschutzanordnung (10) verbunden.

1

Beschreibung

Schaltungsanordnung mit einem Spannungszwischenkreisumrichter

Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung mit einem Spannungszwischenkreisumrichter, der einen Zwischenkreiskondensator und parallel zu diesem angeordnete Schaltzweige, die in Serie geschaltete Schaltelemente aufweisen, enthält, wobei zum Schutz vor Kurzschlussströmen und Überspannungen ein Kurzschlussthyristor vorhanden ist.

Diese Schaltelemente können abschaltbare Bauelemente, wie z.B. Thyristoren, insbesondere GTO-Thyristoren mit antiparallel geschalteten Freilaufdioden, sein.

15

20

25

30

Eine derartige Schaltungsanordnung ist aus dem Sonderdruck aus ZEV-DET Glasers Annalen, Heft 2/3 1994: Rudolf Wagner "Drehstrom-Antriebstechnik für Diesellokomotiven in Nordamerika" bekannt. Die dort beschriebene Drehstromantriebstechnik erfordert den Einsatz eines Spannungszwischenkreisumrichters zwischen der Spannungsversorgung und dem Drehstrommotor. Im Bremsbetrieb werden die Fahrmotoren zu Generatoren, so dass Strom in den Spannungszwischenkreisumrichter zurückgespeist wird. Dabei könnten im Umrichter vorhandene GTO-Thyristoren durch Überströme und Überspannungen beschädigt werden.

Aus dem genannten Aufsatz ist bekannt, zur Verhinderung solcher Schäden ein Hardware-Schutzsystem einzusetzen. Es ist im gleichen Aufsatz auch vorgeschlagen, zum Abbau einer Überspannung einen einfachen Kurzschlussthyristor einzusetzen, da dieser weniger Platz beansprucht und auch kostengünstiger ist als ein Schutzsystem.

Die geschilderten Schutzsysteme können nur eingesetzt werden, 35 wenn der Umrichter GTO-Thyristoren aufweist, da bei diesen die Strombelastbarkeit hoch ist.

2

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schaltungsanordnung mit einem Spannungszwischenkreisumrichter anzugeben,
die die Stoßstrombelastung der Freilaufdioden der Schaltzweige im Schutzfall reduziert und es damit ermöglicht, auch
Freilaufdioden mit geringerer Stoßstrombelastbarkeit als bisher einzusetzen, wie es z.B. bei den Freilaufdioden von
gebondeten IGBT-Modulen der Fall ist. Insbesondere soll es
möglich sein, die Schaltungsanordnung auch dann einzusetzen,
wenn der Umrichter als Schaltelemente IGBTs und deren
Freilaufdioden enthält.

5

10

15

20

25

30

35

Die Aufgabe wird gemäß der Erfindung dadurch gelöst, dass mit dem Zwischenkreiskondensator und mit den Schaltzweigen eine Kurzschlussschutzanordnung verbunden ist, bestehend aus einer Parallelschaltung des Kurzschlussthyristors mit entgegengesetzt zu diesem durchlässigen Paaren von in Serie geschalteten Schutzdioden, dass die Kurzschlussschutzanordnung parallel zum Zwischenkreiskondensator geschaltet ist und dass jeweils ein Anschlusspunkt zwischen zwei in Serie geschalteten Schaltelementen eines Schaltzweiges mit jeweils einem Anschlusspunkt zwischen zwei in Serie geschalteten Schutzdioden der Kurzschlussschutzanordnung verbunden ist.

Die Schutzdioden, die bei der Schaltungsanordnung nach der Erfindung neu sind, sind im Normalbetrieb des Umrichters nicht stromführend. Sie sind auch nicht an den Kommutierungsvorgängen des Umrichters beteiligt. Sie können daher vorteilhafterweise auf geringe Durchlassspannungen und damit auf hohe zulässige Stromstöße, die beim Zünden eines Kurzschließerthyristors auftreten können, optimiert werden. Es ist dabei unerheblich, wenn die Schutzdioden weniger gute Schalteigenschaften haben. Die guten Schalteigenschaften des Umrichters sind nämlich durch die Freilaufdioden der Schaltelemente in den Schaltzweigen gewährleistet.

Insbesondere wird der Vorteil erzielt, dass die guten Schalteigenschaften durch die Freilaufdioden der Schaltzweige ge-

20

25

30

35

3

währleistet sind, während die guten Durchlasseigenschaften durch die Schutzdioden der Kurzschlussschutzanordnung gewährleistet sind. Es ergibt sich eine vorteilhafte Kombination.

In einem Fehlerfall, d.h. bei einem Kurzschluss, wird der Kurzschlussthyristor gezündet, so dass der Zwischenkreiskondensator entladen wird. Nach der Entladung des Zwischenkreiskondensators sind jeweils ein zugeordnetes Schutzdiodenpaar und ein Freilaufdiodenpaar der Schaltelemente eines Schaltzweiges parallel geschaltet. Folglich werden die Freilaufdioden der Schaltzweige durch die Schutzdioden von lastseitig oder netzseitig verursachten Kurzschlussströmen entlastet.

Es wird der Vorteil erzielt, dass besonders die Schaltzweige 15 und die dort vorhandenen Schaltelemente vor Überströmen und Überspannungen geschützt werden.

Beispielsweise ist die Kurzschlussschutzanordnung nur mit dem Zwischenkreiskondensator und den Schaltzweigen der Netzseite verbunden. Nach einem anderen Beispiel ist die Kurzschlussschutzanordnung nur mit dem Zwischenkreiskondensator und den Schaltzweigen der Lastseite verbunden. Mit diesen Alternativen wird der Vorteil erzielt, dass bei Bedarf auch nur die besonders betroffenen Teile des Umrichters vor Kurzschlüssen geschützt werden können.

Die Schaltelemente der Schaltzweige sind beispielsweise IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistor). Solche Transistoren waren bisher selbst in Verbindung mit einem bekannten Schutz vor Kurzschlüssen nicht immer schützbar, da sie Überspannungen und Überströmen weniger gut standhalten können als GTOs. Mit der Schaltungsanordnung nach der Erfindung wird der Vorteil erzielt, dass selbst empfindlichere IGBTs und deren Freilaufdioden zuverlässig vor Kurzschlüssen geschützt werden können.

PCT/DE2003/002016

4

Beispielsweise ist die Kurzschlussschutzanordnung über in zwei Verbindungsleitungen angeordnete zusätzliche Schutzdioden mit dem Zwischenkreiskondensator verbunden, wobei die zusätzliche Schutzdiode der ersten Verbindungsleitung entgegengesetzt zur zusätzlichen Schutzdiode der zweiten Verbindungsleitung durchlässig ist. Damit wird der Schutz vor Kurzschlusströmen weiter verbessert, da diese hinsichtlich der Durchlassrichtung des Kurzschlussthyristors gleichgerichtet werden.

10

5

Beispielsweise sind dem Kurzschlussthyristor strombegrenzende Bauteile zugeordnet. Es kann sich dabei um einen ohmschen Widerstand, eine Induktivität, einen Transformator oder um eine Kombination solcher Bauteile handeln. Solche zusätzlichen

15 Bauteile sind geeignet den Stromfluss weiter zu begrenzen.

Mit der Schaltungsanordnung nach der Erfindung werden mit einfachen Mitteln Kurzschlussströme zuverlässig von einem Umrichter ferngehalten, so dass sogar IGBTs im Umrichter eingesetzt werden können.

Ein Ausführungsbeispiel der Schaltungsanordnung nach der Erfindung wird anhand der Zeichnung näher erläutert:

25 FIG 1 zeigt eine Schaltungsanordnung mit Spannungszwischenkreisumrichter und Kurzschlussschutzanordnung.

FIG 2 zeigt eine Schaltungsanordnung, bei der nur die Netzseite des Umrichters geschützt ist.

30

20

FIG 3 zeigt eine Schaltungsanordnung, bei der nur die Lastseite des Umrichters geschützt ist.

Die FIG 4 und 5 zeigen Varianten für die in den Schaltzweigen 35 vorhandenen in Serie geschalteten Schaltelementenpaare.

5

Die FIG 6 bis 9 zeigen Varianten für strombegrenzende Bauteile in Verbindung mit dem Kurzschlussthyristor.

Nach Figur 1 weist ein üblicher Spannungszwischenkreisumrichter Anschlüsse 1 und 2 für eine Spannungsversorgung und Anschlüsse 3 bis 5 für einen Drehstrommotor auf. Die genannten Anschlüsse 1 bis 5 stehen jeweils mit Schaltzweigen 6a bis 6e und dort mit Anschlusspunkten zwischen in Serie geschalteten Schaltelementen 7a bis 7e einerseits und 8a bis 8e andererseits, in Verbindung. Dabei bildet eine Serienschaltung aus zwei Schaltelementen (z.B. 7a und 8a) einen Schaltzweig (z.B. 6a). Die Schaltzweige 6a bis 6e sind parallel zueinander und zu einem Zwischenkreiskondensator 9 geschaltet.

Mit dem Zwischenkreiskondensator 9 und mit den Schaltzweigen 6a bis 6e ist eine Kurzschlussschutzanordnung 10 verbunden. Diese besteht aus einer Parallelschaltung eines Kurzschlussthyristors 11 mit entgegengesetzt zu diesem durchlässigen Paaren in Serie geschalteter Schutzdioden 12a bis 12e und 13a bis 13e. Außer, dass die Kurzschlussschutzanordnung 10 parallel zum Zwischenkreiskondensator 9 geschaltet ist, ist jeweils ein Anschlusspunkt zwischen zwei in Serie geschalteten Schaltelementen 7a bis 7e und 8a bis 8e eines Schaltzweiges 6a bis 6e mit jeweils einem Anschlusspunkt zwischen zwei in Serie geschalteten Schutzdioden 12a bis 12e und 13a bis13e der Kurzschlussschutzanordnung 10 verbunden.

In den beiden Verbindungsleitungen, durch die die Parallelschaltung des Kurzschlussthyristors 11 mit dem Zwischenkreiskondensator 9 gegeben ist, ist jeweils eine zusätzliche Schutzdiode 14, 15 angeordnet. Diese Schutzdioden 14, 15 sind einander entgegengesetzt durchlässig.

30

In den Figuren 1 bis 3 entsprechen gleiche Bezugszeichen 35 gleichen Bauteilen. Die beiden Ausführungsformen der Figuren 2 und 3 unterscheiden sich von der Ausführungsform nach Figur 1 nur dadurch, dass nach Figur 2 die Kurzschlussschutzvor-

6

richtung 10 nur dem Zwischenkreiskondensator 9 und den Schaltzweigen 6a und 6b der Netzseite zugeordnet ist, während nach Figur 3 die Kurzschlussschutzanordnung 10 nur dem Zwischenkreiskondensator 9 und den Schaltzweigen 6c bis 6e der Lastseite zugeordnet ist.

5

10

15

20

25

30

Die Figuren 4 und 5 zeigen zwei Beispiele, wie ein Schaltzweig 6 mit zwei Schaltelementen 7, 8 aufgebaut sein kann. Figur 4 zeigt zwei GTO-Thyristoren 16, 17 mit deren antiparallelen Freilaufdioden 18, 19, die jeweils in Serie geschaltet sind.

Figur 5 zeigt eine ähnliche Schaltungsanordnung wie Figur 4. Hier sind jedoch IGBT-Transistoren 20, 21 statt der GTO-Thyristoren 16, 17 aus Figur 4 vorhanden.

Die Figuren 6 bis 9 zeigen den Kurzschlussthyristor 11 in Verbindung mit zugeordneten strombegrenzenden Bauteilen. Nach Figur 6 ist eine Induktivität 22 in Serie geschaltet. Nach Figur 7 ist ein ohmscher Widerstand 23 in Serie geschaltet. Nach Figur 8 ist eine Parallelschaltung aus Induktivität 22 und ohmschem Widerstand 23 in Serie geschaltet. Nach Figur 9 ist die Primärwicklung eines Transformators 24 in Serie geschaltet, wobei die Anschlüsse der Sekundärwicklung des Transformators 24 mit einem ohmschen Widerstand 25 verbunden sind.

Mit der Schaltungsanordnung nach der Erfindung können mit einfachen Mitteln infolge von Kurzschlüssen auftretende Überspannungen und Überströme im Umrichter zuverlässig beherrscht werden. Es ist sogar möglich, in den Schaltzweigen 6a bis 6e empfindliche IGBTs und deren Freilaufdioden einzusetzen.

7

Patentansprüche

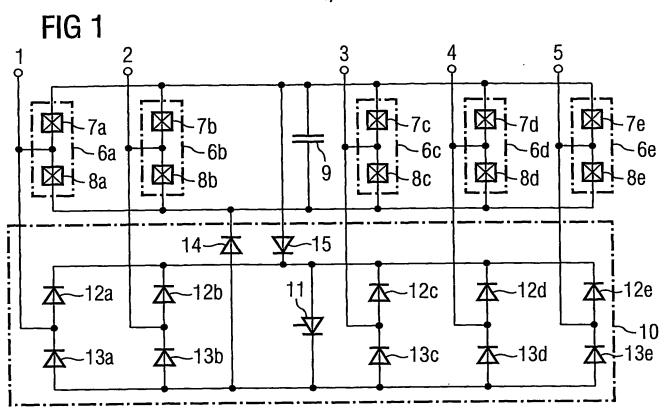
35

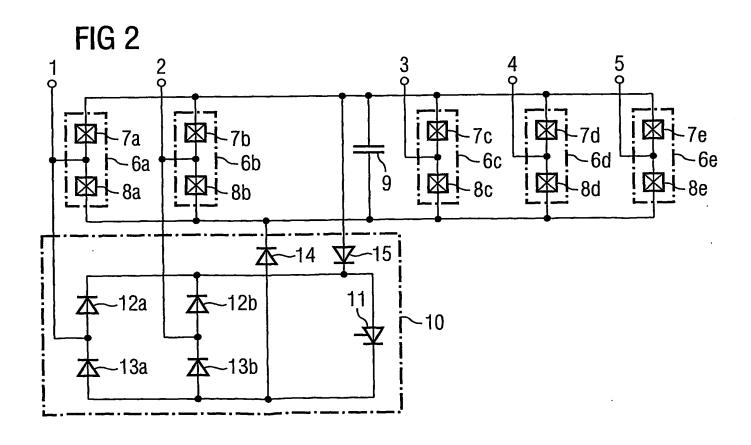
- 1. Schaltungsanordnung mit einem Spannungszwischenkreisumrichter, der einen Zwischenkreiskondensator (9) und parallel zu diesem angeordnete Schaltzweige (6a bis 6e), die in Serie geschaltete Schaltelemente (7a bis 7e und 8a bis 8e) aufweisen, enthält, wobei zum Schutz vor Kurzschlussströmen und Überspannungen ein Kurzschlussthyristor (11) vorhanden ist, gekennzeichnet, dadurch mit dem Zwischenkreiskondensator (9) und mit den Schaltzwei-10 gen (6a bis 6e) eine Kurzschlussschutzanordnung (10) verbunden ist, bestehend aus einer Parallelschaltung des Kurzschlussthyristors (11) mit entgegengesetzt zu diesem durchlässigen Paaren von in Serie geschalteten Schutzdioden (12a bis 12e und 13a bis 13e), dass die Kurzschlussschutzan-15 ordnung (10) parallel zum Zwischenkreiskondensator (9) geschaltet ist und dass jeweils ein Anschlusspunkt zwischen zwei in Serie geschalteten Schaltelementen (7a bis 7e und 8a bis 8e) eines Schaltzweiges (6a bis 6e) mit jeweils einem Anschlusspunkt zwischen zwei in Serie geschalteten Schutzdioden 20 (12a bis 12e und 13a bis 13e) der Kurzschlussschutzanordnung (10) verbunden ist.
 - 2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1,
- 25 dadurch gekennzeichnet, dass die Kurzschlussschutzanordnung (10) nur mit dem Zwischenkreiskondensator (9) und den Schaltzweigen (6a und 6b) der Netzseite verbunden ist.
- 30 3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die
 Kurzschlussschutzanordnung (10) nur mit dem Zwischenkreiskondensator (9) und den Schaltzweigen (6c bis 6e) der Lastseite
 verbunden ist.
 - 4. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

8

dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltelemente (7a bis 7e und 8a bis 8e) der Schaltzweige (6a bis 6e) IGBTs sind.

- 5 5. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die
 Kurzschlussschutzanordnung (10) über in zwei Verbindungsleitungen angeordnete zusätzliche Schutzdioden (14, 15) mit dem
 Zwischenkreiskondensator (9) verbunden ist, wobei die zusätz10 liche Schutzdiode (14) der ersten Verbindungsleitung entgegengesetzt zur zusätzlichen Schutzdiode (15) der zweiten Verbindungsleitung durchlässig ist.
- Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
 dadurch gekennzeichnet, dass dem Kurzschlussthyristor (11) strombegrenzende Bauteile zugeordnet sind.







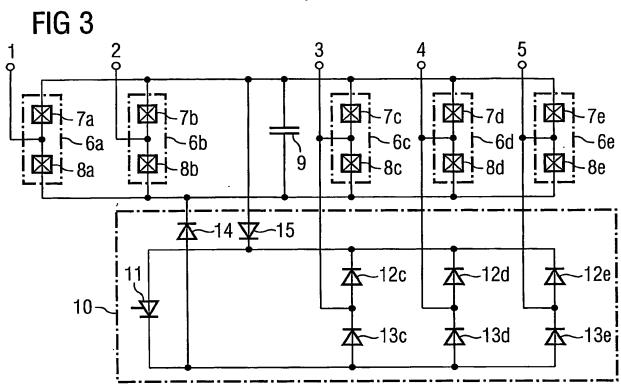
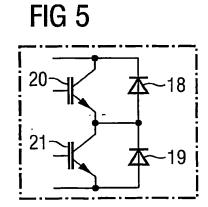
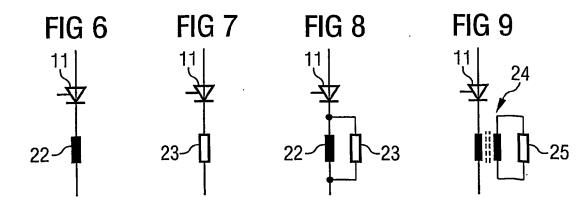


FIG 4

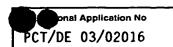
V-16 X-18

V-17 X-19









A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H02M5/458 H02M5/45							
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
B. FIELDS							
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 H02M H02H							
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched							
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data base	ase and, where practical, search terms used)					
EPO-Internal							
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re-	elevant passages	Relevant to claim No.				
X	US 4 005 350 A (BRENNEISEN JORG) 25 January 1977 (1977-01-25) abstract column 4, line 1 - line 11 figure 1	•	1-6				
A	DE 198 33 490 A (SIEMENS AG) 27 January 2000 (2000-01-27) column 1, line 54 - line 66 column 2 figure 1		1-6				
A	WO 01 71900 A (BALDOR ELECTRIC Of 27 September 2001 (2001-09-27) page 2, line 7 - line 11 page 3, line 7 - line 14 page 6, line 1 - line 24 figure 3	COMPANY)	1-6				
Furt	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.				
A docum	ent defining the general state of the art which is not	*T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the					
"E" earlier filing		 invention 'X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone 					
which citation "O" docum	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified) nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled					
P docum	means nent published prior to the International filing date but than the priority date claimed	in the art.					
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	Date of mailing of the international search report				
1	19 November 2003	10/12/2003	10/12/2003				
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2		Authorized officer					
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Marannino, E.					



PCT/DE 03/02016

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 4005350	A	25-01-1977	DE AT AT CH FR GB SE SE	2349161 A1 329659 B 704174 A 570059 A5 2246099 A1 1476743 A 395206 B 7412076 A	10-04-1975 25-05-1976 15-08-1975 28-11-1975 25-04-1975 16-06-1977 01-08-1977
DE 19833490	Α	27-01-2000	DE	19833490 A1	27-01-2000
WO 0171900	Α	27-09-2001	AU WO	4759401 A 0171900 A2	03-10-2001 27-09-2001

a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 H02M5/458 H02M5/45							
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK							
B. RECHER	CHIERTE GEBIETE						
Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H02M H02H							
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen							
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Nat	me der Datenbank und evtl. verwendete S	uchbegriffe)				
EPO-Internal							
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN						
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.				
X	US 4 005 350 A (BRENNEISEN JORG) 25. Januar 1977 (1977-01-25) Zusammenfassung Spalte 4, Zeile 1 - Zeile 11 Abbildung 1		1-6				
А	DE 198 33 490 A (SIEMENS AG) 27. Januar 2000 (2000-01-27) Spalte 1, Zeile 54 - Zeile 66 Spalte 2 Abbildung 1		1-6				
Α	WO 01 71900 A (BALDOR ELECTRIC COI 27. September 2001 (2001-09-27) Seite 2, Zeile 7 - Zeile 11 Seite 3, Zeile 7 - Zeile 14 Seite 6, Zeile 1 - Zeile 24 Abbildung 3	MPANY)	1-6				
Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu X Siehe Anhang Patentfamilie							
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht eine Benutzung, eine vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem internationalen Anmeldedatum, aber nach der Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlichtung, die nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlichung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegend							
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	cherchenberichts				
	19. November 2003	10/12/2003					
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016		Bevollmächtigter Bediensteter Marannino, E.					

PCT/DE 03/02016

Mitglied(er) der Patentfamilie Datum der Datum der Im Recherchenbericht Veröffentlichung Veröffentlichung angeführtes Patentdokument 10-04-1975 25-01-1977 DE 2349161 A1 Α US 4005350 25-05-1976 AT 329659 B 15-08-1975 AT 704174 A 28-11-1975 CH 570059 A5 25-04-1975 FR 2246099 A1 16-06-1977 GB 1476743 A 01-08-1977 SE 395206 B 01-04-1975 SE 7412076 A 27-01-2000 19833490 A1 27-01-2000 DE DE 19833490 Α 03-10-2001 27-09-2001 AU 4759401 A WO 0171900 Α 27-09-2001 WO 0171900 A2